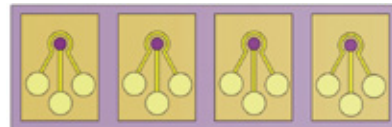


EB-PIN-850-50-01



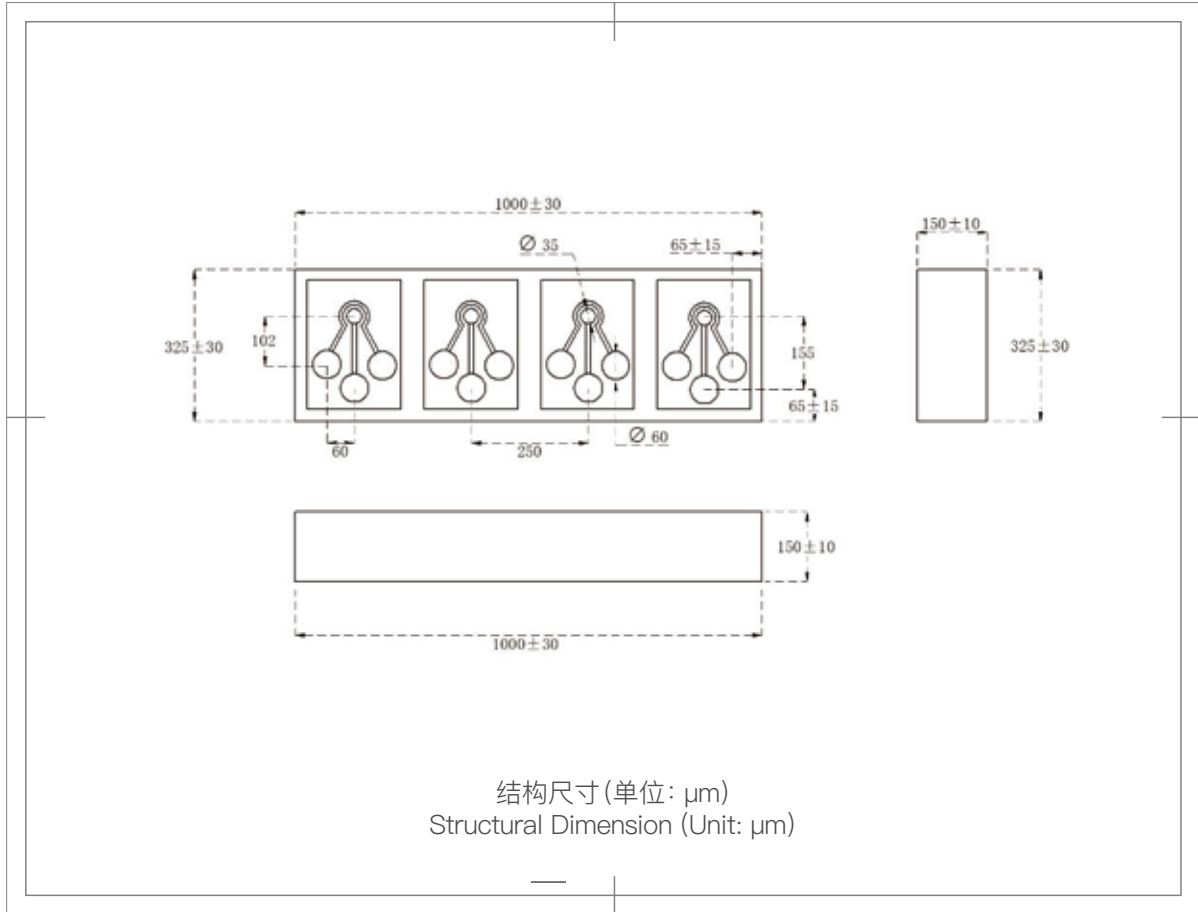
产品型号 Product Code	描述 Description	形态 Type	工作温度 Operating Temperature
EB-4ch PIN-850-50-01	850nm 1x4 50G PIN PD Array	Array, 1*4	0~85°C
EB-1ch PIN-850-50-01	850nm 1x1 50G PIN PD Array	Single Chip	0~85°C

特征/Characteristics

	单位 Unit	最小值 Min	典型值 Typical	最大值 Max	测试条件 Test Condition
响应度/Responsivity	A/W	0.5	0.55		$\lambda_{op} = 850 \text{ nm}, P_{in} = 0 \text{ dBm}, V_r = 2 \text{ V}$
暗电流/Dark Current	nA			0.5	$V_r = 2 \text{ V}, T = 25^\circ\text{C}$
	nA			20	$V_r = 2 \text{ V}, T = 85^\circ\text{C}$
击穿电压 V_{br} /Breakdown Voltage	V	20			$I_d = -10 \mu\text{A}$
电容/Capacitance	fF		130		$V_r = 2 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$
工作波长/Operating Wavelength	nm	840	850	940	
孔径直径/Diameter of Aperture	μm		35		
小信号带宽/3dB Bandwidth	GHz		17		$\lambda_{op} = 850 \text{ nm}, P_{in} = -3 \text{ dBm}, V_r = 2 \text{ V}, T = 25^\circ\text{C}$
	GHz		15		$\lambda_{op} = 850 \text{ nm}, P_{in} = -3 \text{ dBm}, V_r = 2 \text{ V}, T = 85^\circ\text{C}$

备注/Remarks

- 规格型号命名规则：EB (Everbright 长光华芯缩写) PIN - 850(工作波长) - 50(工作速率 50G) - 01(版本号)。
- 在超过极限工作条件下使用时, 会对芯片造成永久性损坏。
- 在临近极限工作条件下长期使用, 可能会对产品性能和寿命产生不利影响。
- 操作芯片时应采取通用的 ESD 防护措施。该芯片采用 ESD 保护包装发货, 将其从包装中取出后, 应在采取 ESD 防护措施的环境中使用, 包括但不限于采用标准接地工作台、脚垫和腕带等 ESD 防护措施。



应用领域 / Applications



数据通信
Data Communication

产品特点 / Features



高带宽和高响应度
High Bandwidth and Responsivity



低暗电流
Low Dark Current



35 μm 大光敏面
Top-illuminated 35 μm Aperture



满足非气密性封装要求
Qualified for Non-hermetic Packages



工作波长范围: 840nm-940nm
Working Wavelength Range:
840nm-940nm

